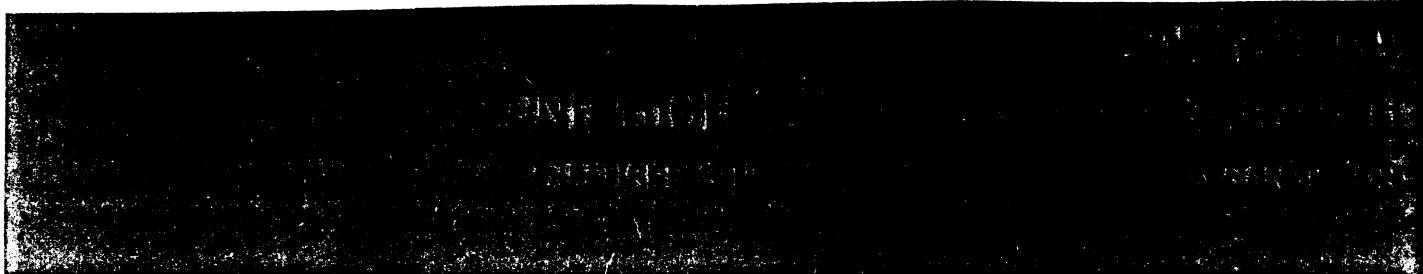


New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

20 STERN AVE.
SPRINGFIELD, NEW JERSEY 07081
U.S.A.

TELEPHONE: (201) 376-2922
(212) 227-6005
FAX: (201) 376-8960



- FAST SWITCHING** -- $t_{on} = 20$ ns (MAX)
-- $t_{off} = 25$ ns (MAX)
-- $\tau_s = 20$ ns (MAX)
- HIGH FREQUENCY** -- $f_T = 800$ MHz (MIN)
- LOW CAPACITANCE** -- $C_{obo} = 4.5$ pF (MAX)
- LOW SATURATION VOLTAGE** -- $V_{CE(SAT)} = 0.13$ V (MAX) @ $I_c = 10$ mA

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS [Note 1]

Maximum Temperatures

| | |
|--|-----------------|
| Storage Temperature | -65°C to +200°C |
| Operating Junction Temperature | 200°C Maximum |
| Lead Temperature (Soldering, 60 second time limit) | 300°C Maximum |

Maximum Power Dissipation

| | |
|--|-----------|
| Total Dissipation at 25°C Case Temperature [Notes 2 and 3] | 1.2 Watts |
| at 100°C Case Temperature [Notes 2 and 3] | 0.72 Watt |
| at 25°C Ambient Temperature [Notes 2 and 3] | 0.36 Watt |

Maximum Voltages

| | |
|---|------------|
| V_{CBO} Collector to Base Voltage | -12 Volts |
| V_{CEO} Collector to Emitter Voltage [Note 4] | -12 Volts |
| V_{EBO} Emitter to Base Voltage | -4.5 Volts |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (25°C Free Air Temperature Unless Otherwise Noted)

| Symbol | Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
|---------------|--|-------|-------|-------|----------------|--|
| t_{on} | Turn On Time [Note 6, Figure 1] | 10 | 20 | ns | | $I_c \approx 30$ mA $I_{B1} \approx 3.0$ mA |
| t_{off} | Turn Off Time [Note 6, Figure 1] | 15 | 25 | ns | | $I_c \approx 30$ mA $I_{B1} \approx I_{B2} \approx 3.0$ mA |
| t_{on} | Turn On Time [Note 6, Figure 2] | 23 | 60 | ns | | $I_c \approx 30$ mA $I_{B1} \approx 1.5$ mA |
| t_{off} | Turn Off Time [Note 6, Figure 2] | 13 | 35 | ns | | $I_c \approx 30$ mA $I_{B1} \approx I_{B2} \approx 1.5$ mA |
| τ_s | Charge Storage Time Constant [Note 6, Figure 3] | 15 | 20 | ns | | $I_c \approx I_{B1} \approx I_{B2} \approx 10$ mA |
| $V_{CE(sat)}$ | Pulsed Collector-Emitter Saturation Voltage [Note 5] | -0.08 | -0.13 | Volts | $I_c = 10$ mA | $I_B = 1.0$ mA |
| $V_{CE(sat)}$ | Pulsed Collector-Emitter Saturation Voltage [Note 5] | -0.12 | -0.19 | Volts | $I_c = 30$ mA | $I_B = 3.0$ mA |
| $V_{CE(sat)}$ | Pulsed Collector-Emitter Saturation Voltage [Note 5] | -0.28 | -0.45 | Volts | $I_c = 100$ mA | $I_B = 10$ mA |
| $V_{BE(sat)}$ | Pulsed Base-Emitter Saturation Voltage [Note 5] | -0.78 | -0.82 | -0.92 | Volts | $I_c = 10$ mA $I_B = 1.0$ mA |
| $V_{BE(sat)}$ | Pulsed Base-Emitter Saturation Voltage [Note 5] | -0.85 | -0.93 | -1.15 | Volts | $I_c = 30$ mA $I_B = 3.0$ mA |
| $V_{BE(sat)}$ | Pulsed Base-Emitter Saturation Voltage [Note 5] | -1.0 | -1.14 | -1.5 | Volts | $I_c = 100$ mA $I_B = 10$ mA |
| h_{fe} | High Frequency Current Gain ($f = 100$ MHz) | 8.0 | 12 | | $I_c = 30$ mA | $V_{CE} = -10$ V |
| C_{obo} | Output Capacitance | 3.3 | 4.5 | pF | $I_E = 0$ | $V_{CB} = -5.0$ V |
| C_{ibo} | Input Capacitance | 4.7 | 6.0 | pF | $I_C = 0$ | $V_{EB} = -0.5$ V |
| I_{CES} | Collector Reverse Current | 0.29 | 50 | nA | $V_{BE} = 0$ | $V_{CE} = -10$ V |

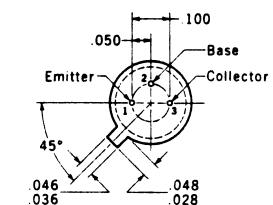
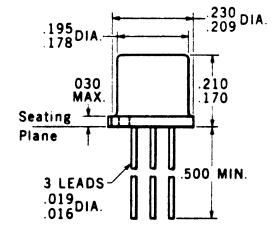
Additional Electrical Characteristics on page 2

NOTES:

- (1) These ratings are limiting values above which the serviceability of any individual semiconductor device may be impaired.
- (2) These are steady state limits. The factory should be consulted on applications involving pulsed or low duty cycle operations.
- (3) These ratings give a maximum junction temperature of 200°C and junction to case thermal resistance of 146°C/watt (derating factor of 6.85 mW/°C); junction to ambient thermal resistance of 486°C/watt (derating factor of 2.06 mW/°C).
- (4) This rating refers to a high current point where collector to emitter voltage is lowest. For more information send for Fairchild Publication APP-4/2.
- (5) Pulse Conditions: length = 300 μs; duty cycle = 1%.

PHYSICAL DIMENSIONS

in accordance with
JEDEC (TO-18) outline



NOTES: All dimensions in inches
Leads are gold plated over
Collector internally connected to case
Package weight is 0.44 gram

New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

20 STERN AVE.
SPRINGFIELD, NEW JERSEY 07081

2N2894A

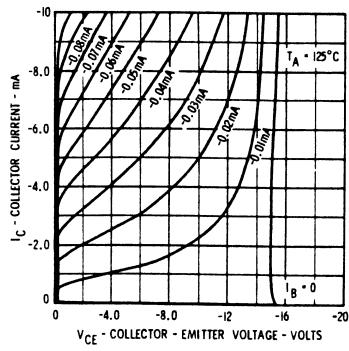
I.I.S.A.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (25°C Free Air Temperature Unless Otherwise Noted)

TELEPHONE: (201) 376-2922
(212) 227-6005
FAX: (201) 376-8960

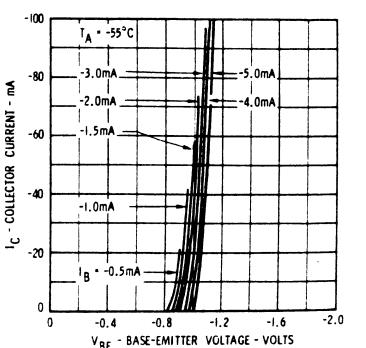
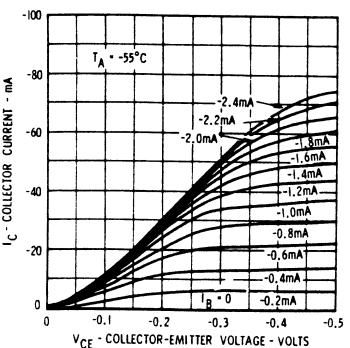
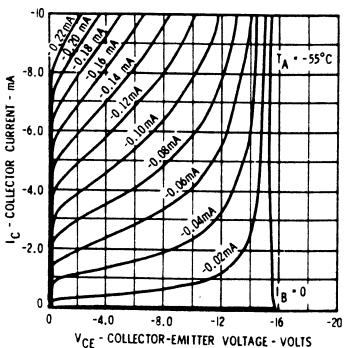
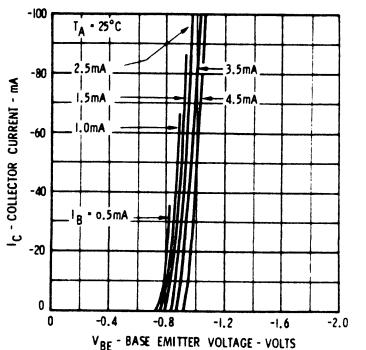
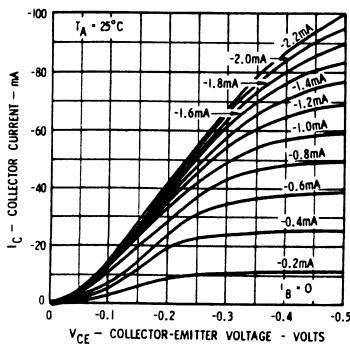
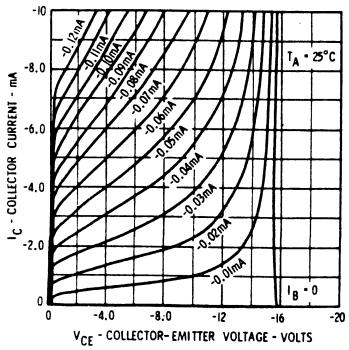
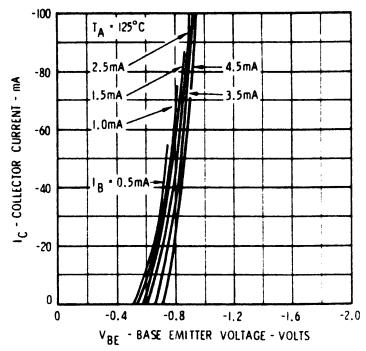
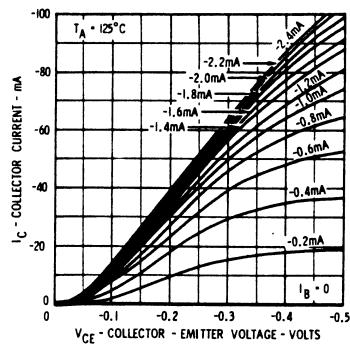
| Symbol | Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
|------------------------------|--|------|------|------|---------|-----------------------------------|
| I_{CBO} (125°C) | Collector Cutoff Current | | | | μA | $I_E = 0$ |
| V_{CEO} (sust) | Collector-Emitter Sustaining Voltage [Notes 4 and 5] | -12 | 0.05 | 10 | Volts | $I_C = 10 \text{ mA}$ (pulsed) |
| BV_{CBO} | Collector-Base Breakdown Voltage | -12 | | | Volts | $I_E = 0$ |
| BV_{CES} | Collector-Emitter Breakdown Voltage | -12 | | | Volts | $I_C = 10 \mu A$ |
| BV_{EBO} | Emitter-Base Breakdown Voltage | -4.5 | | | Volts | $V_{BE} = 0$ |
| h_{FE} | DC Pulse Current Gain [Note 5] | 20 | 44 | | | $I_E = 100 \mu A$ |
| h_{FE} | DC Pulse Current Gain [Note 5] | 30 | 53 | | | $I_C = 1.0 \text{ mA}$ |
| h_{FE} | DC Pulse Current Gain [Note 5] | 40 | 63 | 120 | | $V_{CE} = -0.5 \text{ V}$ |
| h_{FE} | DC Pulse Current Gain [Note 5] | 30 | 55 | | | $I_C = 10 \text{ mA}$ |
| $h_{FE} (-55^\circ\text{C})$ | DC Pulse Current Gain [Note 5] | 20 | 38 | | | $V_{CE} = -0.3 \text{ V}$ |
| | | | | | | $I_C = 30 \text{ mA}$ |
| | | | | | | $V_{CE} = -0.5 \text{ V}$ |
| | | | | | | $I_C = 30 \text{ mA}$ |
| | | | | | | $V_{CE} = -1.0 \text{ V}$ |
| | | | | | | $I_C = 30 \text{ mA}$ |
| | | | | | | $V_{CE} = -0.5 \text{ V}$ |

TYPICAL COLLECTOR AND BASE CHARACTERISTICS*

ACTIVE REGION



SATURATION REGION





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331